











| | |
|---|---|
|  | <h2>SI7440DP-T1-GE3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI7440DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7440DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3506 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | SI7440DP-T1-GE3 |
| Hersteller | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 3506 pcs Stock |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 30V 12A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount |
| Serie | TrenchFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® SO-8 |
| Verlustleistung (max) | 1.9W (Ta) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 12A (Ta) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 6.5 mOhm @ 21A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 35nC @ 4.5V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |

SI7440DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7440DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7440DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7440DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>SI7442DP Vishay Precision Group SI7442DP VISHAY</p> |  <p>SI7444DP-T1-E3 Vishay Precision Group SI7444DP-T1-E3 VISHAY</p> |  <p>SI7440DP-T1-E3 QFN8 VISHAY SI7440DP-T1-E3 QFN8 VISHAY</p> |  <p>SI7444DP SI SI7444DP SI</p> |
|  <p>SI7440DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7440DP-T1 VISHAY SI7440DP-T1 VISHAY</p> |  <p>SI7440DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A PPAK SO-8</p> |  <p>SI7442DP-T1-E3 VISHAY SI7442DP-T1-E3 VISHAY</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ⚙ SI7423DN-T1-GE3 | ↔ SI7425DN-T1-E3 | ➔ SI7425DN-T1-E3 | D SI7430DP-T1-E3 | ➔ SI7430DP-T1-E3 |
| ⊣ SI7430DP-T1-GE3 | ⚙ SI7430DP-T1-GE3 | D SI7431DP | ➔ SI7431DP-T1-E3 | ➔ SI7431DP-T1-E3 |
| ⚙ SI7431DP-T1-GE3 | ⊣ SI7431DP-T1-GE3 | ⚙ SI7434DP | ↔ SI7434DP-T1-E3 | ➔ SI7434DP-T1-E3 |
| D SI7434DP-T1-GE3 | ⚙ SI7434DP-T1-GE3 | ⊣ SI7439DP-T1-E3 | ⚙ SI7439DP-T1-E3 | ➔ SI7439DP-T1-GE3 |
| ➔ SI7439DP-T1-GE3 | ↔ SI7440DP | ⚙ SI7440DP-T1 | ⊣ SI7440DP-T1-E3 | ➔ SI7440DP-T1-E3 |
| ↔ SI7440DP-T1-GE3 | ➔ SI7442DP-T1 | D SI7442DP-T1-E3 | ⚙ SI7444DP-T1-GE3 | ⊣ SI7445DP-T1 |
| ⚙ SI7445DP-T1-E3 | D SI7445DP-T1-E3 | ➔ SI7445DP-T1-GE3 | ↔ SI7445DP-T1-GE3 | ➔ SI7446BDP |
| ⊣ SI7446BDP-T1-E3 | ⚙ SI7446BDP-T1-E3 | ↔ SI7446BDP-T1-GE3 | ➔ SI7446BDP-T1-GE3 | ➔ SI7446BDP-T1-T3 |
| ⚙ SI7446DP | ⊣ SI7446DP-T1 | ⚙ SI7446DP-T1-GE3 | D SI7446DP-T1 | ➔ SI7447ADP |
| ↔ SI7447ADP-T1-E3 | ⚙ SI7447ADP-T1-E3 | ⊣ SI7447ADP-T1-GE3 | ⚙ SI7447ADP-T1-GE3 | ➔ SI7447DP-T1-GE3 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited